# (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 18. Oktober 2001 (18.10.2001)

**PCT** 

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/78163 A1

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: 51/20, G03F 7/00

H01L 51/40,

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE01/01444

(22) Internationales Anmeldedatum:

12. April 2001 (12.04.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

100 18 168.6 12. April 2000 (12.04.2000) DI

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH & CO. OHG [DE/DE]; Wernerwerkstrasse 2, 93049 Regensburg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (mur für US): BLÄSSING, Jörg [DE/DE]; Geschwister-Scholl-Strasse 1, 91058 Erlangen (DE). WITTMANN, Georg [DE/DE]; Erlenstrasse 10a, 91074 Herzogenaurach (DE). STÖSSEL, Matthias [DE/DE]; Äussere Tennenloher Strasse 47, 91058 Erlangen (DE).

- (74) Anwait: EPPING HERMANN & FISCHER; Postfach 12 10 26, 80034 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CA, CN, JP, KR, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

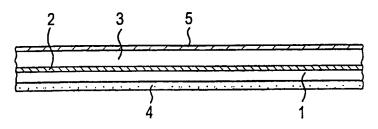
#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\u00fcr Änderungen der Anspr\u00fcche geltenden Frist; Ver\u00f6ffentlichung wird wiederholt, falls \u00e4nderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING ORGANIC LIGHT-EMITTING DIODES

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON ORGANISCHEN, LICHT EMITTIERENDEN DIODEN



(57) Abstract: The invention relates to a method for producing organic light-emitting diodes (OLED's) (2.3.5). Whereas in prior art production methods, the color conversion layers (4) were applied in a contactless manner to a substrate (1) using ink jet printing methods, the invention now uses printing methods which directly impinge upon the substrate, namely methods involving

the use of a printing form. Flexographic printing and offset printing, for example, function according to this technique.

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zum Herstellen von organischen, Licht emittierenden Dioden (OLEDs) (2.3.5) vorgeschlagen. Während bei herkömmlichen Herstellungsverfahren die Farbkonversionsschichten (4) mit Hilfe von Ink-Jet-Durckverfahren berührungslos auf ein Substrat (1) aufgebracht werden, werden nun Druckverfahren verwendet, die das Substrat direkt beaufschlagen, nämlich solche Verfahren, die eine Druckform verwenden. Nach dieser Technik arbeiten beispielsweise der Flexodruck und der Offsetdruck.

O 01/78163 A1

WO 01/78163 PCT/DE01/01444

1

#### Beschreibung

Verfahren zum Herstellen von organischen, Licht emittierenden Dioden

5

25

30

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von organischen, Licht emittierenden Dioden (OLEDs), die beispielsweise zur Herstellung von Flachbildschirmen verwendbar sind.

Die Leuchtfähigkeit von Dioden der genannten Art beruht auf der Eigenschaft bestimmter organischer Materialien, bei angelegter Spannung Licht auszusenden. Je nach dem verwendeten Material können so unterschiedliche Farbeffekte erreicht werden. Vielfach werden die aus den genannten Materialien bestehenden Emitterschichten mit einer Farbkonversionsschicht kombiniert. Diese Schichten bestehen aus einem Material, das die von dem Emittermaterial ausgesandten Lichtwellen absorbiert und mit längerer Wellenlänge wieder abstrahlt. Die Farbkonversionsschichten können entweder großflächig oder in Form von Pixeln aufgetragen sein.

Aus der WO 98/28946 ist ein Verfahren bekannt, bei dem Farbkonversionsschichten mit einem von Tintenstrahldruckern her
bekannten Verfahren aufgebracht werden. Die auch als Ink-JetVerfahren bezeichneten Druckverfahren arbeiten berührungslos,
indem das Farbkonversionsmaterial aus feinen Düsen auf die
zu beschichtende Fläche aufgebracht wird. Farbkonversionsschichten sind im Allgemeinen sehr empfindlich gegenüber
Störeinflüssen, etwa wechselnden Schichtdicken oder unebenen
Schichtoberflächen. Mit dem Tintenstrahldruckverfahren lässt
sich aber eine glatte Oberfläche nur sehr schwer erreichen.
Außerdem ist eine exakte Abgrenzung der einzelnen Pixel
gegeneinander schwierig zu bewerkstelligen.

35 Aufgabe der Erfindung ist es, ein Herstellungsverfahren vorzuschlagen, mit dem sich Farbkonversionsschichten auf technisch einfache, schonende und zuverlässige Weise derart auf-

PCT/DE01/01444 WO 01/78163

2

bringen lassen, dass sie eine gleichmäßige Schichtdicke und eine glatte Oberfläche aufweisen.

Diese Aufgabe wird nach Anspruch 1 dadurch gelöst, dass die 5 Farbkonversionsschicht unter Verwendung einer Druckform auf ein Substrat aufgebracht wird.

Druckverfahren, die eine Druckform verwenden, sind der Flachdruck (z.B. Offsetdruck), der Hochdruck (z.B. Buchdruck und Flexodruck), der Tiefdruck und der Durchdruck. Beim Flach-10 druck liegen die druckenden und die nicht-druckenden Bereiche in einer Ebene, während beim Hochdruck die druckenden Teile erhaben aus der Druckformebene hervorstehen. Beim Tiefdruck sind die druckenden Teile vertieft. Beim Durchdruck, dessen bekanntester Vertreter der Siebdruck ist, ist die Druckform ein sehr feines Maschenwerk. Mit den genannten Druckverfahren lassen sich sowohl großflächige Konversionsschichten als auch solche mit pixelförmiger Rasterung herstellen. Als Substrat dient vorzugsweise ein Glassubstrat oder eine transparente flexible Folie.

Die Erfindung wird nun anhand der Herstellung zweier in den beigefügten Zeichnungen dargestellten Dioden näher erläutert. Es zeigen:

einen schematischen Querschnitt durch eine groß-FIG 1 25 flächige einfarbige Diode und

schematische Draufsichten auf eine Diode, die das FIG 2-4 sukzessive Aufbringen der verschiedenen Schichten darstellen.

30

20

In FIG 1 ist eine einfarbige Diode mit großflächig aufgebrachten funktionellen Schichten dargestellt. Auf die eine Seite eines Glassubstrats 1 ist eine Schicht 2 aus ITO aufgebracht, die als Anode arbeitet. Als Substrat kann auch eine transparente flexible Folie dienen. Auf die ITO-Schicht 2 sind eine oder mehrere funktionelle organische Schichten 3 beispielsweise durch thermisches Verdampfen aufgebracht. Die

WO 01/78163 PCT/DE01/01444

3

funktionellen organischen Schichten 3 sind so gewählt, dass sie blaues Licht emittieren. Auf die organischen Schichten 3 ist Calcium als Kathode 5 abgeschieden. Auf die andere Seite des Glassubstrats 1 ist mit Hilfe eines Offset-Druckverfahrens großflächig eine Farbkonversionsschicht 4 aufgebracht.

Bei der in FIG 2-4 dargestellten Diode handelt es sich um einen vergrößerten Ausschnitt einer vollfarbigen Diode. Auf ein Glassubstrat ist zunächst eine Farbkonversionsschicht mit einem der oben genannten Druckverfahren in Form einer Pixelmatrix aufgedruckt. Dabei wechseln sich Pixel 6, 7 mit rot und grün konvertierenden Materialien mit einem freien Platz 8 ab. Die Pixel 6, 7 und der freie Platz 8 bilden zusammen ein übergeordnetes Pixel 9. Die Pixel 6, 7 und der frei bleibende Pixel 8 haben Abmessungen von ca. 80  $\mu$ m x 280  $\mu$ m. Der Abstand zwischen den Pixeln beträgt ca. 20  $\mu$ m. Auf diese Pixelmatrix wird nun großflächig ITO aufgesputtert (= Horizontalschraffur 10 in Fig. 3). Diese Schicht wird photolithographisch zu parallelen Streifen mit einer Breite von ebenfalls 80 um und einem Abstand von 20  $\mu m$  strukturiert. Als nächster Schritt werden rechtwinklig zu den ITO-Streifen Photolackstreifen 11 mit einer Breite von ca. 30  $\mu$ m aufgebracht (Fig. 4). Nun werden die funktionellen organischen Schichten durch thermisches Verdampfen oder durch Aufbringen aus Lösung abgeschieden. Schließlich wird dann noch großflächig eine Kathode aufgedampft.

10

15

20

25

4

#### Patentansprüche

- Verfahren zum Herstellen von organischen, Licht emittierenden Dioden, bei dem wenigstens eine Farbkonversionsschicht unter Verwendung einer Druckform auf ein Substrat aufgedruckt wird.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Farbkonversionsschicht auf ein
  Glassubstrat aufgedruckt wird.
  - 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Farbkonversionsschicht auf eine transparente flexible Folie aufgedruckt wird.

WO 01/78163

PCT/DE01/01444

1/2

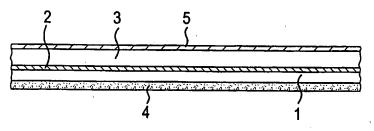


Fig. 1

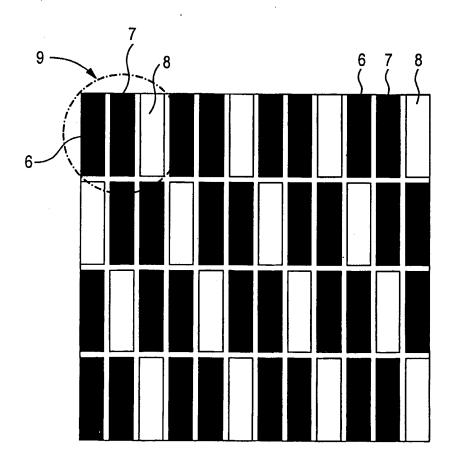
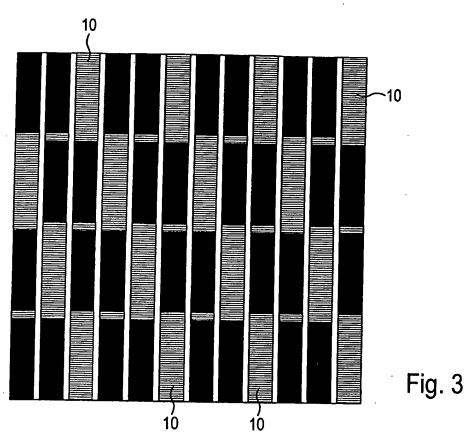
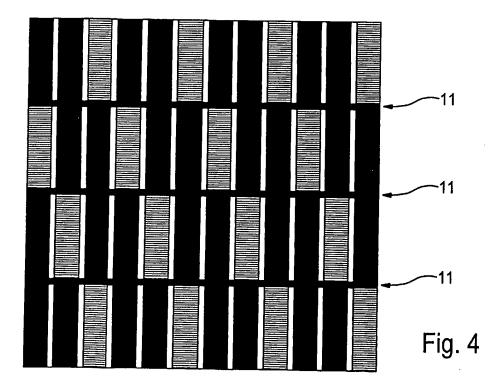


Fig. 2

2/2





THIS PAGE BLANK (USPTO

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Ir Ional Application No PCT/DE 01/01444

A CLAS	CUPO A TION OF OUR LEAD AND PROP		107702 01701444
ÎPC 7	SSIFICATION OF SUBJECT MATTER H01L51/40 H01L51/20 G03F	7/00	
According	g to International Patent Classification (IPC) or to both national c	lassification and IPC	
	DS SEARCHED		
IPC 7	documentation searched (classification system followed by clas H01L G03F	sification symbols)	
	tation searched other than minimum documentation to the extent		
	data base consulted during the international search (name of data	ata base and, where practical,	search terms used)
EPO-Ir	nternal, INSPEC		·
C. DOCUM	IENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of ti	he relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 884 370 A (TDK CORP) 16 December 1998 (1998-12-16) page 4, line 30 - line 37 page 6, line 51 - line 53		1-3
x	GB 2 333 897 A (FUJI ELECTRIC 4 August 1999 (1999-08-04) page 10, last paragraph	1,2	
P,X	EP 1 065 725 A (SEMICONDUCTOR 3 January 2001 (2001-01-03) paragraph '0007! - paragraph paragraph '0019! paragraph '0074!	·	1-3
Furthe	er documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family me	mbers are listed in annex.
A' document consider consider consider consider consider consent consent consent consent consent consent consent consent consent consider	t which may throw doubts on priority claim(s) or cited to establish the publication date of another or other special reason (as specified) at referring to an oral disclosure, use, exhibition or eans	or priority date and no cited to understand the invention  "X" document of particular cannot be considered involve an inventive si "Y" document of particular cannot be considered document is combined ments, such combined ments, such combined in the combined combined in the combined combined in the combined combined combined combined combined combined combined combined combined cited to combined c	ed after the international filing date to conflict with the application but a principle or theory underlying the relevance; the claimed invention novel or cannot be considered to ep when the document is taken alone relevance; the claimed invention to involve an inventive step when the light one or more other such doculon being obvious to a person skilled
later than	t published prior to the international filing date but n the priority date claimed	in the art. "&" document member of the	
	July 2001	Date of mailing of the 0	nternational search report
	iling address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Agne, M	

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

onal Application No PCT/DE 01/01444

Patent document cited in search report	rt	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0884370	Α	16-12-1998	JP US	10338872 A 6023371 A	22-12-1998 08-02-2000
GB 2333897	A	04-08-1999	JP	11219786 A	10-08-1999
EP 1065725	Α	03-01-2001	CN	1279515 A	10-01-2001

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

i ionales Aktenzeiche PCT/DF 01/01444

		ľ	101/06 01/01444	
A. KLASS IPK 7	SIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L51/40 H01L51/20 G03F7/(	00		
Nach der Ir	nternationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen K	Classifikation und der IPK		
B. RECHE	RCHIERTE GEBIETE			
Recherchie IPK 7	erter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssym H01L G03F	ibole )		
Recherchie	nte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen,	sowelt diese unter die rech	erchlerten Gebiele fallen	
Während de	er Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank	/Name der Datenbank un	savit verwendete Suchbegriffe)	
	ternal, INSPEC			
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie*	Bezeichnung der Verölfentlichung, soweit erforderlich unter Anga	be der in Betracht komme	nden Telle Betr. Anspruch Nr.	
X .	EP 0 884 370 A (TDK CORP) 16. Dezember 1998 (1998-12-16) Seite 4, Zeile 30 - Zeile 37 Seite 6, Zeile 51 - Zeile 53		1-3	
X	GB 2 333 897 A (FUJI ELECTRIC CO 4. August 1999 (1999-08-04) Seite 10, letzter Absatz	LTD)	1,2	
P,X	EP 1 065 725 A (SEMICONDUCTOR EN 3. Januar 2001 (2001-01-03) Absatz '0007! - Absatz '0015! Absatz '0019! Absatz '0074!	ERGY LAB)	1-3	
Weite entne	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu hmen	X Siehe Anhang P	alentfamilie	
*Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen  *A' Veröffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist   *E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist   *L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweilehaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichung beteigt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)  *O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht  *P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum der Oder dem Prioritätsdatum veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlichung von besondern Prioritätsdatum veröffentlichung veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindum veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte erfindum veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindum veröffentlichung von besond				
	. Juli 2001	08/08/20	otemationalen Recherchenberichts	
Name und Po	stanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bed Agne, M	iensteter	

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ir onales Aktenzeichen
PCT/DE 01/01444

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitgiled(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
EP	0884370	A	16-12-1998	JP US	10338872 A 6023371 A	22-12-1998 08-02-2000
GB	2333897	Α	04-08-1999	JP	11219786 A	10-08-1999
EP	1065725	Α	03-01-2001	CN	1279515 A	10-01-2001